

|   |   |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">SISA16DN-T1-GE3</h2>                  |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> SISA16DN-T1-GE3                |
|   | <b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay       |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8 |
|   | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform                   |
|   | <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.           |
|   | <b>Liefern von:</b> Hong Kong                                 |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

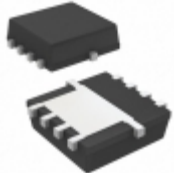
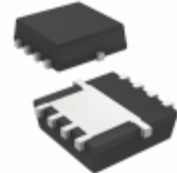

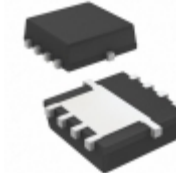
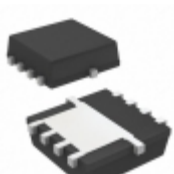



### Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | SISA16DN-T1-GE3                                  |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                     |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8                  |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.3V @ 250µA                                     |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® 1212-8                                 |
| Serie  | TrenchFET®                                       |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 6.8 mOhm @ 15A, 10V                              |
| Verlustleistung (max)                            | -  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                 |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® 1212-8                                 |
| Andere Namen                                     | SISA16DN-T1-GE3TR                                |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                    |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                    |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 22 Weeks   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 2060pF @ 15V                                     |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 47nC @ 10V                                       |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 30V 16A (Ta) Surface Mount PowerPAK®   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 16A (Ta)   |
| Basisteilenummer                                 | SISA16   |

SISA16DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA16DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA16DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISA16DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SISA14DN-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>   |  <p><b>SISA18DN-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p> |  <p><b>SiSA14DN</b><br/>Vishay<br/>SiSA14DN Vishay</p>   |  <p><b>SISA16DN-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p> |
|  <p><b>SISA18ADN-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p> |  <p><b>SISA18ADN-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>            |  <p><b>SiSA18ADN</b><br/>Vishay<br/>SiSA18ADN Vishay</p> |  <p><b>SISA12DN-T1-GE3</b><br/>VISHAY<br/>SISA12DN-T1-GE3 VISHAY</p>                    |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                             |                              |                       |   |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| SISA16DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SISA16DN-T1-GE3 Datenblatt  | SISA16DN-T1-GE3-Datenblätter | SISA16DN-T1-GE3 PDF   | Electro-Films (EFI) / Vishay<br>SISA16DN-T1-GE3 |
| SISA16DN-T1-GE3 Electronic                   | SISA16DN-T1-GE3-Komponenten | SISA16DN-T1-GE3-Verteiler    | SISA16DN-T1-GE3-Bild  | SISA16DN-T1-GE3-Teil                            |
| SISA16DN-T1-GE3 Preis                        | SISA16DN-T1-GE3 Hersteller  | SISA16DN-T1-GE3 Bild         | SISA16DN-T1-GE3 Aktie | SISA16DN-T1-GE3 Inventar                        |
| SISA16DN-T1-GE3 Neu                          | SISA16DN-T1-GE3 Original    | SISA16DN-T1-GE3 garantiert   | SISA16DN-T1-GE3 RFQ   | SISA16DN-T1-GE3 Online bestellen                |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited